| PLANO DE DISCIPLINA  |                       |                                |  |
|--|-----------------------|--------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO  |                       |                                |  |
| CURSO: Engenharia Elétrica   |                       |                                |  |
| DISCIPLINA: Eletrônica I   |                       | CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0222 |  |
| PRÉ-REQUISITO(S): Circuitos Elétricos I                            |                       |                                |  |
| UNIDADE CURRICULAR: Obrig  | atória [X] Optativa [ | [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE: 5°   |  |
| VÁLIDO PARA O(S) PERÍODO(S) LETIVO(S): 2017.2 em diante            |                       |                                |  |
| CARGA HORÁRIA  |                       |                                |  |
| TEÓRICA: 70 horas  | PRÁTICA: 13 horas     | EaD:                           |  |
| CARGA HORÁRIA SEMANAL: 05 horas-aula CARGA HORÁRIA TOTAL: 83 horas |                       |                                |  |
| DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Cristóvão Mácio de Oliveira Lima Filho |                       |                                |  |

### **EMENTA**

Junção PN. Conceitos, aplicações de diodos semicondutores e diodos especiais. Transistor bipolar e transistor de efeito de campo: construção, características, polarização e modelagem. Análise para pequenos sinais dos transistores bipolares e de efeito de campo: configurações, ganho, eficiência, distorção, ruído, resposta em frequência, impedância de entrada e de saída, efeitos das impedâncias de carga e da fonte e estabilidade.

### **OBJETIVOS**

**Geral**: analisar e projetar circuitos com diodos semicondutores, transistores bipolares e transistores de efeito de campo.

Específicos: ao final da disciplina espera-se que os alunos tenham capacidade de: identificar as características do diodo semicondutor e descrever o funcionamento de circuitos com diodos; descrever o comportamento do transistor bipolar de junção (TBJ) nas regiões de corte, saturação e na região ativa; calcular os parâmetros re e os parâmetros híbridos para as configurações base-comum, coletor-comum e emissor-comum com transistores TBJ; realizar cálculos de projetos de circuitos amplificadores com polarização fixa e para pequenos sinais com TBJ, FET e MOSFET.

# CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1. Diodo semicondutor: introdução ao estudo do diodo: materiais semicondutores; diodo ideal, o diodo semicondutor; circuitos equivalentes, curva característica; o diodo retificador: retificador de meia-onda e de onda completa; circuitos ceifadores, grampeadores e multiplicadores com diodos; diodo Zener; circuitos com diodo Zener; fontes reguladas com Zener.
- 2. Transistores bipolares de junção: introdução ao estudo do transistor bipolar de junção TBJ (curva característica, ponto de operação); reta de carga; características gerais do TBJ em configurações basecomum, emissor-comum e coletor comum; o transistor bipolar como chave; circuitos com TBJ com polarização fixa, estável, por divisor de tensão, cc com realimentação de tensão e com polarizações combinadas; amplificação no domínio ca e seus principais parâmetros (beta ca, impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão e ganho de corrente); modelagem do transistor bipolar de junção: modelo re, base comum, emissor comum e coletor comum; modelo híbrido equivalente (emissor comum, base comum e coletor comum); determinação gráfica dos parâmetros híbridos (hie, hoe, hfe e hre); análise do TBJ para pequenos sinais (configurações emissor-comum com polarização fixa, polarização por divisor de tensão, configuração emissor-comum com polarização do emissor, configuração seguidor-deemissor, configuração com realimentação do coletor, configuração base comum, configuração com realimentação co do coletor, circuito híbrido equivalente aproximado e completo).
- 3. O transistor de efeito de campo: JFET (construção e características); MOSFET (tipos e aplicações); polarização do FET (configuração com auto-polarização, polarização fixa, polarização por divisor de tensão); análise do FET para pequenos sinais (circuito JFET com polarização fixa, autopolarização, divisor de tensão, seguidor-de-fonte); MOSFET do tipo depleção e do tipo intensificação; circuito E-MOSFET com realimentação de dreno e com divisor de tensão; projetos de circuitos amplificadores com FET.



## METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas com recursos audiovisuais, aulas práticas com montagens em protoboard e simulações utilizando *softwares* específicos; Serão aplicados trabalhos individuais e em grupos, tanto lista de exercícios como seminários.

| RECURSOS DIDÁTICOS                   |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| [X] Quadro                           | [ ] Equipamento de Som                      |  |
| [ X ] Projetor                       | [ X ] Laboratório de eletrônica             |  |
| [ ] Vídeos/DVDs                      | [ X ] Softwares: de simulação computacional |  |
| [ ] Periódicos/Livros/Revistas/Links | [ ] Outros:                                 |  |

## CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Provas escritas; apresentações de seminários; trabalhos práticos e teóricos e listas de exercícios. Relatórios dos experimentos práticos. Mínimo de três (3) avaliações.

## **BIBLIOGRAFIA**

### Bibliografia Básica:

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. Microeletrônica. São Paulo: Pearson, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos Circuitos. São Paulo: Pearson, 2013.

RAZAVI, B. Fundamentos de Microeletrônica. Rio de Janeiro: LTC / Grupo Gen, 2010.

### **Bibliografia Complementar:**

CIPELLI, A. M. V. *et al.* Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos. São Paulo: Érica / Saraiva, 2008.

COMER, D. J.; COMER, D. T. Fundamentos de Projeto de Circuitos Eletrônicos. Rio de Janeiro: LTC / Grupo Gen, 2005.

MALVINO, A.; BATES, D. J. Eletrônica – Volume 1. Porto Alegre: McGraw-Hill / Grupo A, 2008.

RAZAVI, B. Fundamentals of Microelectronics. Hoboken (USA): Wiley, 2008.

SANTOS, E. J. P. Eletrônica Analógica: Integrada e Aplicações. São Paulo: Livraria da Física, 2011.

